

2Д907
полупроводниковые диодные
матрицы с общим катодом

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диодные матрицы полупроводниковые (ДМП) 2Д907Б-1, 2Д907Г-1 предназначены для применения в неремонтируемых гибридных схемах, блоках и аппаратуре, обеспечивающей герметизацию и защиту приборов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы, пониженного и повышенного давления.

Обозначение технических условий

- ДР3.362.014 ТУ

Рисунок 1. 2Д907Г-1

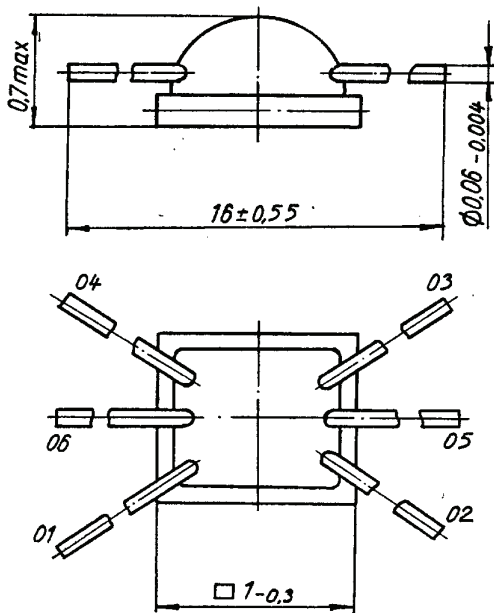


Схема соединения электродов с выводами

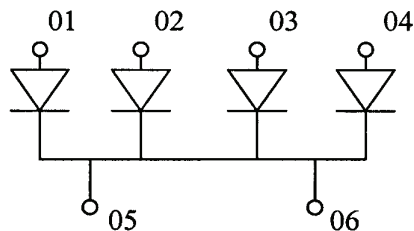


Рисунок 2. 2Д907Б-1

Остальное см. рисунок 1

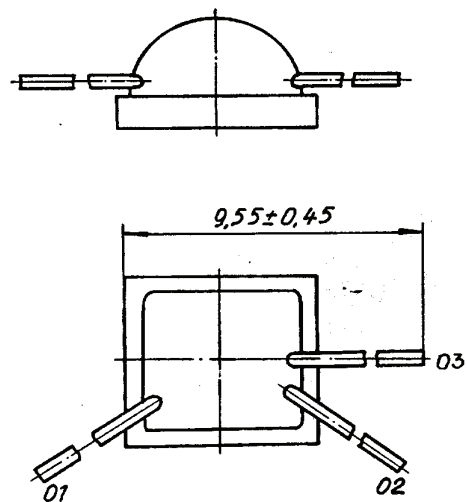


Схема соединения электродов с выводами

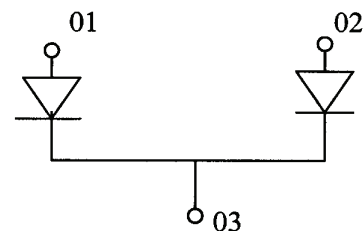


Таблица 1. Основные электрические параметры 2Д907 при $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Максим. значение
Постоянный обратный ток, мкА, при $U_{\text{обр}} = 40\text{ В}$	$I_{\text{обр}}$	5,0
Постоянное прямое напряжение, В, при $I_{\text{пр}} = 50\text{ мА}$	$U_{\text{пр}}$	1,0
Общая емкость диода ДМП, пФ, при $U_{\text{обр}} = 0$	$C_{\text{д}}$	5,0
Заряд восстановления диода, пКл, при $I_{\text{пр}} = 50\text{ мА}$, $U_{\text{обр,и}} = 10\text{ В}$	$Q_{\text{вос}}$	500



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>